Short Report

愚者の金を利用した薄膜太陽電池に関する検討

SPS 法で作製した硫化鉄試料の電気伝導特性

山口博之¹, 金子駿也¹, 長南安紀¹, 小谷光司¹, 小宮山崇夫¹, 杉山重彰², 菅原靖², 関根崇²

1 秋田県立大学システ科学技術学部知能メカトロニクス学科

2 秋田県産業技術センター

サステイナブルで高性能な太陽電池材料として期待される硫化鉄(愚者の金)であるが、その課題は接合における低い光起電力にあ る.この低い光起電力は硫化鉄試料に内因的に存在するノンストイキオメトリ(硫黄欠損)や残留不純物に由来するとの研究報告が 多数なされており、本研究では SPS 法・真空焼結法で作製した試料,ならびに秋田県産黄鉄鉱について、ストイキオメトリに注意 しながら電子物性を調べた.これまでに SPS 法により硫化鉄試料を作製した報告が見当たらず SPS 処理中の焼結に必要な温度が不 明であったが、収縮の様子を観察した結果、硫化鉄は 700 K以上で焼結が進むことがわかった.773 K で 20 分焼結させることで熱 分解せずに相対密度 84%の試料を得た.SPS 処理時間が長いほど硫黄/鉄の濃度比が増加し、その濃度比が増加すると正のゼーベ ック係数が減少(正孔濃度が上昇)した.SPS 試料の活性化エネルギーは 13 meV で、CVD 法で得た他の人工結晶や天然結晶のそれ に比して低かった.SPS 法により硫黄欠損が少なく深い準位の密度も低い硫化鉄試料を合成できる可能性が示唆された.

キーワード:硫化鉄、黄鉄鉱、太陽電池、SPS、ストイキオメトリ

現在使用されている太陽電池はシリコン(Si)で 構成されているものが主流を占める.ただ,Siを得 るには原料の酸化シリコン(SiO₂)を還元する必要 がある.また,Siは間接遷移型半導体であることか ら光吸収係数が低く,太陽光を十分に吸収して光エ ネルギーを取り込むには300 µmもの厚みが必要に なる.このようにSiは材料コストがかかる一方で, 近年の世界的に太陽電池の需要が急増し,Si太陽電 池は価格が高騰している.このような背景のもと, 安価でサステイナブルな別の材料を用いた薄膜太陽 電池の開発が望まれている.

代替材料の有力候補の一つとして期待されている のが愚者の金, すなわち硫化鉄(FeS₂:黄鉄鉱)で ある.FeS₂は過去には硫酸の原料としての利用価値 があり,重要な工業的資源と重宝されていた.秋田 県には火山や温泉の多いことから,硫化物である FeS2も多く埋蔵されていることが予想できるが,事 実,小坂鉱山(秋田県鹿角郡小坂町)や阿仁鉱山(秋 田県北秋田郡阿仁町,現,北秋田市)といった鉱山 は,日本国内でも FeS2の有力な産出地として知られ ていた.しかしながら原油から硫黄(S)が化学的 に得られるようになった現在,FeS2の工業的用途は 失われ,その価値は下落してしまった.ところが, 後述するように FeS2の薄膜太陽電池原材料として の優れたポテンシャルが知られるようになり,近年 世界中の研究者の注目を浴びている.

FeS₂は可視~近赤外領域での光吸収係数 α が非常 に高く($\alpha \sim 6 \times 10^5$ cm⁻¹),太陽光エネルギーを吸収 するには膜厚が 20 nm もあれば十分である.光吸収 係数が高いとされる CdTe や CIGS でさえも 1 μ m の 厚さが必要であることを考慮すれば,これは大きな 優位性と言える.Si で必要な厚さ 300 μ m と比較す

責任著者連絡先:山口博之 〒015-0055 由利本荘市土谷字海老ノロ 84-4 公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部知能メカ トロニクス学科. E-mail: yamaguchi@akita-pu.ac.jp

ると1000分の1であり材料が少なくて済むため,必 然的に太陽電池のコスト削減につながる. バンドギ ャップの大きさも 1.1~1.2 eV と理想値 1.34 eV に近 いので理論的な値として変換効率は 30%程度が見 込める. さらに、地表面付近での埋蔵量が多く毒性 も低いといった数々の特長を有するため、次世代薄 膜太陽電池の原材料として利用できる安価でサステ イナブルな材料と言える. すでに FeS2 において高い 光電流が得られることは報告されており太陽光照射 で効率的に光キャリアが生成されることは確認され ている. (Yu Bi, Yongbo Yuan, Christopher L. Exstrom, Scott A. Darveau, and Jinsong Huang, 2011) 一方で, FeS2を用いた接合における光起電力は最大で 0.1 eV という低い値に長い間とどまっており、これが FeS2 太陽電池の実用化を妨げている. (AhmedEnnaoui, and HelmutTributsch, 1984) 課題となっている低い起 電力の原因についてはいくつかの可能性が議論され ているが, 数々の研究報告の結果から, 光起電力を 高めるには内因的に存在する化学量論比からのずれ (ノンストイキオメトリ)による硫黄欠損をなくす

(欠損に起因する高い残留キャリア密度および高い 暗電流を抑制する)ことが重要とされている.

(Sudhanshu Shukla et al., 2016) また FeS_2 は 873 K から熱分解し FeS+S へ変化し, それに伴い硫黄欠 損量 x が増加する.(Weizhi Lv, Dunxi Yu, JianqunWu, Lian Zhang, and Minghou Xu, 2015) 合成時に高温処 理の時間をなるべく短縮すれば硫黄欠損の量を抑制 できる可能性がある.そこで本研究では, SPS 法, 真空焼結法で作製した FeS_2 試料および秋田県産天 然黄鉄鉱について, ストイキオメトリに注意し硫黄 欠損量を評価したうえで, 電子物性との関連を調べ た.また, 今後 PLD (パルスレーザー堆積) 法を用 いて FeS_2 薄膜を作製するためのターゲットとして, 高密度の FeS_2 ペレットを用意することも目指した.

試料の準備

SPS 法は硬質材料を得るのに有力な手段として知られている.加圧した状態で原料にパルス通電を行い内部発生するジュール熱を利用することで,短時間の熱処理で高密度の試料を得ることができる.(関

根 崇, 仁野 章弘, 菅原 靖, 杉山 重彰, 泰松 斉, 2016) したがって SPS 法は, 硫黄欠損の少ない FeS₂ 試料を得るのにも有効な手段となる可能性がある. 我々は秋田県産業技術センターの通電加熱焼結装置 (住友石炭鉱業: SPS-2080) を用いて SPS 法による 焼結体を用意した. 純度 3N の FeS₂ 粉末試薬

(80mesh)を真空度 6 Pa, 一軸加圧 50 MPa, 昇温速 度 50 K/min, 焼結温度 773 K, 焼結時間 10 および 20 min で焼結した. この他, 純度 3N の FeS₂粉末試薬 を 200 MPa で加圧整形した後, 同センターの真空焼 結装置(富士電波工業:ハイマルチ 5000)を用い, 真空度 4 Pa, 昇温速度 33 K/min, 焼結温度 650 K, 焼結時間 30 min で真空焼結させた試料も用意した. さらに秋田県大館市釈迦内鉱山産の天然黄鉄鉱(図 1)を購入し, 水晶群の中に析出している硫化鉄結晶 を選別しこれも試料とした.



図1秋田県大館市釈迦内鉱山産天然黄鉄鉱.



図2 SPS 処理による試料の Z 変位 (収縮)の温度 依存性 (インセットは試料への加圧の模式図).

実験結果および考察

図 2 に SPS 処理中の粉末試料における加圧軸方向 収縮による Z 変位の温度依存性を示す. 300~400 K および 600 K 以上,の領域で粉末試料の収縮が進ん でいる様子が分かる. 300~400 K では粒子の再配列 が生じ,600 K 以上で焼結が始まり,700 K 以上で焼 結が急激に進んでいることが分かる.



図3 SPS処理における試料の収縮Z変位の焼結時 間依存性.

図3に773Kに温度を保持して焼結したときの試 料収縮の時間依存性を示す. 焼結開始後10分で1.7 mm 収縮し、さらに 10 分の経過で 0.4 mm 収縮し、 緻密化が進んでいることが分かる. 試料の充填率(理 想的単結晶と比較した相対密度)を評価した結果. 真空焼結試料が 50%, SPS-10min 試料が 78%, SPS-20min 試料が 84%, 天然黄鉄鉱が 99% であった. スパッタリングや PLD 用の市販ターゲットの相対 密度がおおむね 80~90%以上であることを考慮すれ ば、SPS 焼結処理を 20 分施した試料にはまずまずの 密度を与えられたといえる.図3を見る限り、縮小 によるZ変位はSPS 焼結時間を増やせばもう少し緻 密化できそうである.ただ,焼結時間経過に伴う収 縮の度合いはなまってきており、より充填率を高め る(90%以上)には焼結温度をより高くするなどし たほうがよさそうである.

次に,真空中 773 K で SPS 焼結させたことによる FeS_2 試料の熱分解の有無を確認するために XRD (X 線回折)による分析を行った. 図4を見る限り,少 なくとも XRD の検出感度を超える不純物は析出し ていないことから,773K での SPS 焼結で熱分解は

しなかったと判断した.



図 4 773 K で 10 分間で SPS 焼結した FeS₂ 試料の XRD パターン.



図 5 各種 FeS₂ 試料におけるゼーベック係数と, SEM-EDX での硫黄/鉄の信号強度比の相関.

図5にSEM-EDX(走査型電子顕微鏡-エネルギー 分散型X線分光装置)により評価した,各種試料の 硫黄(S)/鉄(Fe)の原子数比およびゼーベック 係数の相関を示す.SEM-EDXで得たFeに対するS の信号強度比は、真空焼結試料で1.15,SPS-10min, SPS-20minがそれぞれ1.28,1.43,天然黄鉄鉱で1.25 となった.原料の粉末試薬で1.27であったので,粉 末試料のS/Fe比率を2:1と仮定すれば,真空焼 結試料,SPS-10min,SPS-20min 試料,天然黄鉄鉱で のS/Fe比率はそれぞれ1.81,2.01,2.25,1.95と 見積もることができる.SPS-20min 試料で硫黄の比 率が2を超えた(原料試薬よりもS/Fe比率が増し た)理由はまだ明らかにできていないものの,SPS 処理を20分施すことで,硫黄の比率が最も高く硫黄 欠損の少ない試料が得られたと言える.ゼーベック 係数は真空焼結試料, SPS-10min, SPS-20min 試料で は正の値(p型半導体)をとり,天然黄鉄鉱では負 の値を示した(n型半導体).ゼーベック係数Sはキ ャリア濃度と負の相関にあり,初等的な半導体物理 によれば次式で表される.(G.D. Mahan, 1998)

$$S = \frac{k_B}{e} \left(\ln \frac{n_0}{n} + \delta \right)$$

ここで、 k_B はボルツマン定数、eは素電荷、 δ は 1 程度の定数であり、 n_0 は以下で表される(m はキ ャリアの質量、T は温度、 \hbar はプランク定数).

$$n_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{2mK_BT}{\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

したがって図5の結果は、硫黄/鉄の原子数比が 増大するに従い正孔濃度も増大し、この正孔の起源 は過剰な硫黄(格子間硫黄、鉄置換硫黄、鉄欠損な ど)に由来することを示唆している. 天然黄鉄鉱で は硫黄/酸素の原子数比が SPS-10min 試料と同等の 値であるにもかかわらず, ゼーベック係数は SPS-10min とは異なり負の値を示したが、これは天 然黄鉄鉱に含まれる微量な残留不純物の影響と考え られる. 黄鉄鉱は黄銅鉱(CuFeS2)と同時に産出さ れる場合が多く,また水晶も鉱石の中に含まれるこ とが多い.実際、実験に用いた天然黄鉄鉱の周辺に は細かい水晶(SiO₂)が多数析出していた(図 1). すでに、天然黄鉄鉱においては Si, 銅(Cu) および アルミニウム (Al) がドナーとして働くことが報告 されている. (R. Schieck, A. Hartmann, S. Fiechter, R. Könenkamp, and H. Wetzel, 1990) 本研究にお いて用いた天然黄鉄鉱の場合でも、ごく微量の残留 不純物 (Si および Cu) が n 型電気伝導を引き起こし た可能性が高い.

接合界面に深い欠陥準位が高密度で存在する場合, 光キャリアの寿命が短くなったり,接合における逆 バイアスでの漏れ電流が大きくなったりする.以下 のように活性化エネルギーからギャップ間準位の深 さを評価した.図6が各種 FeS2試料における電気伝 導率の温度依存性である.真空焼結,SPS-10min, SPS-20min 試料の室温での電気伝導率はそれぞれ 0.5,870,1150 mS/cm であり,いずれも半導体的な

温度変化を示した.真空焼結試料の電気伝導率が著 しく低いのは充填率が低いこと、それに伴う試料の 劣化,が原因と推測される.アレニウスプロットの 傾きから見積もった活性化エネルギーは真空焼結, SPS-10min, SPS-20min 試料についてそれぞれ 15.4, 11.6, 13.5 meV である. Schieck らによれば, 人工 結晶の場合,化学気相成長 (Chemical Vapor Transport: CVT) 法で得られた試料, ならびに高温 溶液成長(High Temperature Solution Growth: HTSG) 法で得られた試料、の室温での電気伝導率はそれぞ れ 60、570~1250 mS/cm であり、いずれもn 型伝導 である.活性化エネルギーはCVT 試料で200~380, HTSG 試料で350 meV と報告されている.(R. Schieck, et al., 1990) これらに比べ本研究で得られた試料は, 電気伝導率は同等である一方,伝導型はp型で活性 化エネルギーも 10 meV 程度と小さい点で異なる. CVT や HTSG 試料のキャリア(電子)が硫黄欠損に 由来する一方,本研究で得た SPS 試料のキャリア(正 孔)は過剰な硫黄に由来するもので,後者は前者に 比べエネルギー準位の深さが浅いものと解釈できる.



図 6 各種 FeS₂ 試料における電気伝導率の温度依 存性(アレニウスプロット).

図 6 で示されるように、本研究で用いた天然黄鉄 鉱試料の電気伝導率は温度上昇に伴い、30 から 100 K にかけて約 1050 mS/cm で一定、100 から 300 K に かけて 870 mS/cm まで緩やかに減少した. このよう な電気伝導率の温度依存性はスペインやアメリカ、 日本で産出された黄鉄鉱試料でも同様に報告されて おり, すべての不純物がイオン化している出払い領 域として解釈されている. (R. Schieck, et al., 1990) 本研究で作製した FeS₂ 試料と市販 ZnO ターゲッ トを用い, 貼りあわせ法にて構築したヘテロ接合の 電流 (I) -電圧 (V) 特性を図7に示す.



図 7 FeS₂ 試料 (SPS-10min 試料および天然黄鉄 鉱) と ZnO のヘテロ接合における I-V 特性.

天然黄鉄鉱を用いた場合,ショットキー特性が見 られる一方,暗電流も大きくリーキーであるのに対 し,SPS-10min 試料では暗電流も小さく,pn 接合で 典型的にみられる良好な I-V 特性が観測できた.整 流比は前者が 5.26 であるのに対し,後者は 250 であ る.これは SPS-10min 試料では界面での欠陥準位濃 度が低いことを示唆する.

結論

太陽電池材料として高い性能を期待される一方で まだ実用化されていない硫化鉄であるが、それは光 起電力が低く変換効率が低いためである。その原因 とされているのが硫黄欠損に由来するノンストイキ オメトリであり、本研究ではノンストイキオメトリ と電子物性の相関を調べた. SPS 法により作製する ことで相対密度 84%の試料が得られたが、その試料 は硫黄の原子濃度比が高く p型電気伝導を示し、活 性化エネルギーも約 10 meV と小さかった. SPS 法 で得た試料は AZO とのヘテロ接合においても漏れ 電流が少なく整流性の高い良好な I-V 特性を示した. SPS 法を採用することで、深い準位となる硫黄欠損 が少なく残留不純物に由来する欠陥も少ない硫化鉄 試料が得られることが示唆された.

謝辞

本研究の一部は、「平成 30 年度ユーラス研究助 成・地域活性化支援事業研究費」の補助により行わ れた.また、秋田大学の布田潔先生には天然黄銅鉱・ 黄鉄鉱に関する貴重なご助言を頂いた.ここに記し て、謝意を表する.

文献

- Yu Bi, Yongbo Yuan, Christopher L. Exstrom, Scott
 A. Darveau, and Jinsong Huang (2011). Air Stable,
 Photosensitive, Phase Pure Iron Pyrite Nanocrystal
 Thin Films for Photovoltaic Application. Nano Lett.
 11, 4953-4957.
- Ahmed Ennaoui, and Helmut Tributsch (1984). Iron sulphide solar cells. Solar Cells 13, 197-200.
- Sudhanshu Shukla, Guichuan Xing, Hu Ge, Rajiv Ramanujam Prabhakar, Sinu Mathew, Zhenghua Su, Venkatram Nalla, Thirumalai Venkatesan, Nripan Mathews, Thirumany Sritharan, Tze Chien Sum, and Qihua Xiong (2016). Origin of Photocarrier Losses in Iron Pyrite (FeS₂) Nanocubes. ACS Nano 10, 4431-4440.
- Weizhi Lv, Dunxi Yu, JianqunWu, Lian Zhang, and Minghou Xu (2015). The chemical role of CO₂ in pyrite thermal decomposition. Proceedings of the Combustion Institute, 35, 3637-3644.
- 関根 崇, 仁野 章弘, 菅原 靖, 杉山 重彰, 泰 松 斉, (2016).「TiC-SiC 硬質セラミックスの合 成と機械的性質. 粉体および粉末冶金」 63, 912-917.
- G. D. Mahan (1998). Good Thermoelectrics. Solid State Physics, 51, 81-157.
- R. Schieck, A. Hartmann, S. Fiechter, R. Könenkamp, and H. Wetzel (1990). Electrical properties of natural and synthetic pyrite (FeS₂) crystals. J. Mater. Res., 5, 1567-1572.

2019年6月30日受付
 2019年7月9日受理
 2019年7月9日受理

Synthesis of FeS₂ by SPS Method

Fool's gold as a hopeful candidate of Solar Energy Material

Hiroyuki Yamaguchi¹, Syun-ya Kaneko¹, Yasunori Chonan¹, Koji Kotani¹, Takao Komiyama¹, Shigeaki Sugiyama², Yasushi Sugawara², Takashi Sekine²

¹ Department of Intelligent Mechatronics, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University ² Akita Prefectural Industrial Technology Center

Iron pyrite (Fool's gold, FeS₂) is a hopeful candidate for a sustainable and high performance solar energy material. However, the conversion efficiency of FeS₂ based solar cells is still low due to its low photovoltage. This has been attributed to non-stoichiometry resulting from sulfur vacancies and residual impurities. In this work, we studied the stoichiometry and electronic properties of FeS₂ specimens prepared by SPS (Spark Plasma Sintering) and vacuum sintering, and natural crystal mined in Akita prefecture. During the SPS procedure, FeS₂ powders shrank significantly and sintered above 700 K. We obtained FeS₂ ceramics with a relative density of 84% without thermal decomposition via SPS treatment at 773 K for 20 minutes. By increasing SPS sintering time, both the atomic ratio of sulfur to iron in specimens and hole density increased. The activation energy of carriers was estimated to be 13 meV which is small compared to the previous reported values. SPS could be a useful method for synthesizing FeS₂ without the creation of sulfur vacancies and deep level defects.

Keywords: FeS2, iron pyrite, solar cell, SPS, stoichiometry

Correspondence to Hiroyuki Yamaguchi, Department of Intelligent Mechatronics, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University, 84-4 Tsuchiya-Ebinokuchi, Yurihonjyo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: yamaguchi@akita-pu.ac.jp